

半导体学报

第10卷 第6期 1989年6月

目 录

- 用超精细分裂计算研究非晶硅中 $g = 2.0055$ ESR 谱 贾勇强 秦国刚 (403)
ZnS:Mn, Sm 材料中 Mn 中心与不同的 Sm 中心的相互作用及温度的影响 许武 张新夷 徐叙瑢 (411)
MPNIM 结构光致变电容效应 朱长纯 刘君华 J. M. Xu. (419)
 $\text{Cu}_2\text{S}/\text{CdS}$ 太阳电池稳定性机理的研究 肖亦农
王守臣 董殿洪 王兴瑞 王福善 常俊玲 袁淑贞 史恩栋 李红卫 (426)
硅中 Pd-B 络合物性质的理论研究 吴汲安 周洁 张大仁 (434)
扩展电阻分析对砷在硅中本征扩散系数的研究 卢志恒 罗晏 王大椿 (441)
高剂量离子注入激光退火 SOM 上硅膜的 Raman 光谱
..... 钱佑华 冷静民 林成鲁 邢昆山 (449)
氮离子注入形成 SOI 结构的外延研究
..... 林成鲁 李金华 方子韦 邹世昌 (453)
离子束增强沉积氮化硅薄膜生长及其性能研究
..... 柳襄怀 薛滨 郑志宏 周祖尧 邹世昌 (457)

研 究 简 报

- 关于圆柱边界突变结的击穿电压 陈星弼 李肇基 李忠民 (463)
 MoS_2 激子效应的压电光声研究
..... 王桂芬 马根源 王宣 张光寅 钟源 秦利 (467)
n型 LEC-GaAs 中 E_s 能级的研究 张芊 王占国 万寿科 林兰英 (471)

研 究 快 报

- Si/a-Si:H 异质结微波双极型晶体管实验研究
..... 王因生 盛文伟 汪建元 张晓明 熊承堃 朱恩均 (475)
a-Si:H 带尾态的光致变化 孔光临 毛自力 (479)